

Тиристор быстродействующий импульсный ТБИ253-1000-22



| | | | |
|--|------------|----------------------------|------|
| Средний прямой ток | I_{TAV} | 1000 А | |
| Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | U_{DRM} | 1800 - 2200 В | |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | U_{RRM} | | |
| Время выключения | t_q | 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 мкс | |
| $U_{DRM}, U_{RRM}, В$ | 1800 | 2000 | 2200 |
| Класс по напряжению | 18 | 20 | 22 |
| $T_j, ^\circ C$ | - 60 ÷ 125 | | |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

| Обозначение и наименование параметра | | Ед. изм. | Значение | Условия измерения |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|---|
| Параметры в проводящем состоянии | | | | |
| I_{TAV} | Средний ток в открытом состоянии | А | 1000 1255 | $T_c=75^\circ C$; двухстороннее охлаждение; $T_c=55^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц |
| I_{TRMS} | Действующий ток в открытом состоянии | А | 1570 | $T_c=75^\circ C$; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц |
| I_{TSM} | Ударный ток в открытом состоянии | кА | 18.0 21.0 | $T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$ 180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс |
| | | | 19.0 22.0 | $T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$ 180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс |
| I^2t | Защитный фактор | A^2c10^3 | 1600 2200 | $T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$ 180 эл. град. синус; $t_p=10$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс |
| | | | 1400 2000 | $T_j=T_{jmax}$ $T_j=25^\circ C$ 180 эл. град. синус; $t_p=8.3$ мс; единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ А/мкс |

| Блокирующие параметры | | | | |
|------------------------|---|------------------|--|--|
| U_{DRM}, U_{RRM} | Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | В | 1800, 2200 | $T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто |
| U_{DSM}, U_{RSM} | Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | В | 1900, 2300 | $T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто |
| U_D, U_R | Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение | В | $0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$ | $T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто |
| Параметры управления | | | | |
| I_{FGM} | Максимальный прямой ток управления | А | 8 | $T_j = T_{j\max}$ |
| U_{RGM} | Максимальное обратное напряжение управления | В | 5 | |
| P_G | Максимальная рассеиваемая мощность по управлению | Вт | 8 | $T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления |
| Параметры переключения | | | | |
| $(di_T/dt)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz) | А/мкс | 2000 | $T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = 2$ А; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 2$ А/мкс |
| Тепловые параметры | | | | |
| T_{stg} | Температура хранения | °С | - 60 , 50 | |
| T_j | Температура р-п перехода | °С | - 60 , 125 | |
| Механические параметры | | | | |
| F | Монтажное усилие | кН | 24.0, 28.0 | |
| a | Ускорение | м/с ² | 50 | В зажатом состоянии |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение и наименование характеристики | Ед. изм. | Значение | Условия измерения | |
|---|---|----------|---------------------|---|
| Характеристики в проводящем состоянии | | | | |
| U_{TM} | Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс | В | 2.35 | $T_j = 25$ °С; $I_{TM} = 3140$ А |
| $U_{T(ТО)}$ | Пороговое напряжение, макс | В | 1.20 | $T_j = T_{j\max}$; $0.5 I_{TAV} < I_T < 1.5 I_{TAV}$ |
| r_T | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс | МОм | 0.47 | |
| I_H | Ток удержания, макс | мА | 500 | $T_j = 25$ °С; $U_D = 12$ В; управление разомкнуто |
| Блокирующие характеристики | | | | |
| I_{DRM}, I_{RRM} | Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс | мА | 150 | $T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$ |
| $(du_D/dt)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин | В/мкс | 200, 320, 500, 1000 | $T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто |

| Характеристики управления | | | | | |
|---------------------------|--|----|----------------------|--|---|
| U_{GT} | Отпирающее постоянное напряжение управления, макс | В | 4.00 2.50 2.00 | $T_j = T_{j\ min}$ $T_j = 25\ ^\circ C$ $T_j = T_{j\ max}$ | $U_D = 12\ В; I_D = 3\ А;$ Постоянный ток управления |
| I_{GT} | Отпирающий постоянный ток управления, макс | мА | 500 300 200 | $T_j = T_{j\ min}$ $T_j = 25\ ^\circ C$ $T_j = T_{j\ max}$ | |
| U_{GD} | Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин | В | 0.25 | $T_j = T_{j\ max};$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ | Постоянный ток управления |
| I_{GD} | Неотпирающий постоянный ток управления, мин | мА | 10.00 | | |

| Динамические характеристики | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------|--|--|
| t_{gd} | Время задержки включения, макс | мкс | 0.90 | $T_j = 25\ ^\circ C; U_D = 1000\ В; I_{TM} = I_{TAV};$ $di/dt = 200\ А/мкс;$ | |
| t_{gt} | Время включения ²⁾ | мкс | 2.00, 2.50, 3.20, 4.00 | Импульс управления: $I_G = 2\ А; U_G = 20\ В;$ $t_{GP} = 50\ мкс; di_G/dt = 2\ А/мкс$ | |
| t_q | Время выключения ³⁾ , макс | мкс | 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 | $du_D/dt = 50\ В/мкс;$ | $T_j = T_{j\ max}; I_{TM} = I_{TAV}; di_R/dt = -10\ А/мкс;$ $U_R = 100\ В;$ $U_D = 0.67 U_{DRM}$ |
| | | | 25.0, 32.0, 40.0, 50.0 | $du_D/dt = 200\ В/мкс;$ | |
| Q_{rr} | Заряд обратного восстановления, макс | мкКл | 450 | $T_j = T_{j\ max}; I_{TM} = I_{TAV}; di_R/dt = -50\ А/мкс ;$ $U_R = 100\ В$ | |
| t_{rr} | Время обратного восстановления, макс | мкс | 6.3 | | |
| I_{rrM} | Ток обратного восстановления, макс | А | 175 | | |

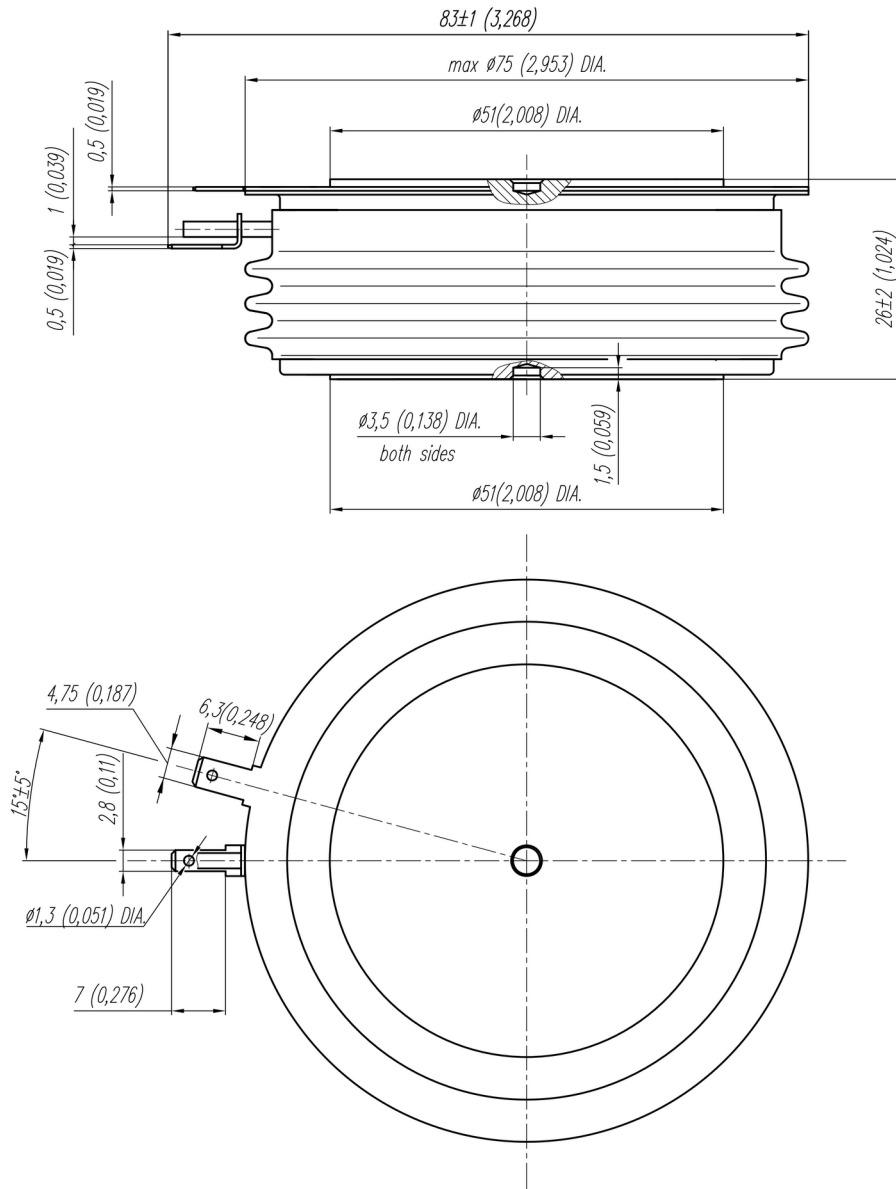
| Тепловые характеристики | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|--------|----------------|------------------------------|
| R_{thjc} | Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс | $^\circ C/Вт$ | 0.0210 | Постоянный ток | Двухстороннее охлаждение |
| R_{thjc-A} | | | 0.0462 | | Охлаждение со стороны анода |
| R_{thjc-K} | | | 0.0378 | | Охлаждение со стороны катода |
| R_{thck} | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс | $^\circ C/Вт$ | 0.004 | Постоянный ток | |

| Механические характеристики | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|--|--|
| w | Масса, макс | г | 550 | | |
| D_s | Длина пути тока утечки по поверхности | мм (дюйм) | 29.47 (1.160) | | |
| D_a | Длина пути тока утечки по воздуху | мм (дюйм) | 17.50 (0.689) | | |

| МАРКИРОВКА | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----|----|------|---|--|--|--|--|--------------------|----|----|----|----|---------------------------|-----|-----|-----|------|--------------------|----|----|----|----|---------------|------|------|------|------|--------------------|----|----|----|----|------------|------|------|------|------|
| ТБИ | 253 | 1000 | 22 | A2 | P3 | P4 | УХЛ2 | ¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P2</th> <th>K2</th> <th>E2</th> <th>A2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$(dv_D/dt)_{crit}, В/мкс$</td> <td>200</td> <td>320</td> <td>500</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table> ²⁾ Время включения <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P4</th> <th>M4</th> <th>K4</th> <th>H4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$t_{gt}, мкс$</td> <td>2.00</td> <td>2.50</td> <td>3.20</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> ³⁾ Время выключения ($du_D/dt = 50\ В/мкс$) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th> <th>P3</th> <th>M3</th> <th>K3</th> <th>H3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$t_q, мкс$</td> <td>20.0</td> <td>25.0</td> <td>32.0</td> <td>40.0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Обозначение группы | P2 | K2 | E2 | A2 | $(dv_D/dt)_{crit}, В/мкс$ | 200 | 320 | 500 | 1000 | Обозначение группы | P4 | M4 | K4 | H4 | $t_{gt}, мкс$ | 2.00 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | Обозначение группы | P3 | M3 | K3 | H3 | $t_q, мкс$ | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 |
| Обозначение группы | P2 | K2 | E2 | A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $(dv_D/dt)_{crit}, В/мкс$ | 200 | 320 | 500 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обозначение группы | P4 | M4 | K4 | H4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $t_{gt}, мкс$ | 2.00 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обозначение группы | P3 | M3 | K3 | H3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $t_q, мкс$ | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Тиристор быстродействующий импульсный 2. Конструктивное исполнение 3. Средний ток в открытом состоянии, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения ($du_D/dt = 50\ В/мкс$) 7. Группа по времени включения 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: T.D2, PT53



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

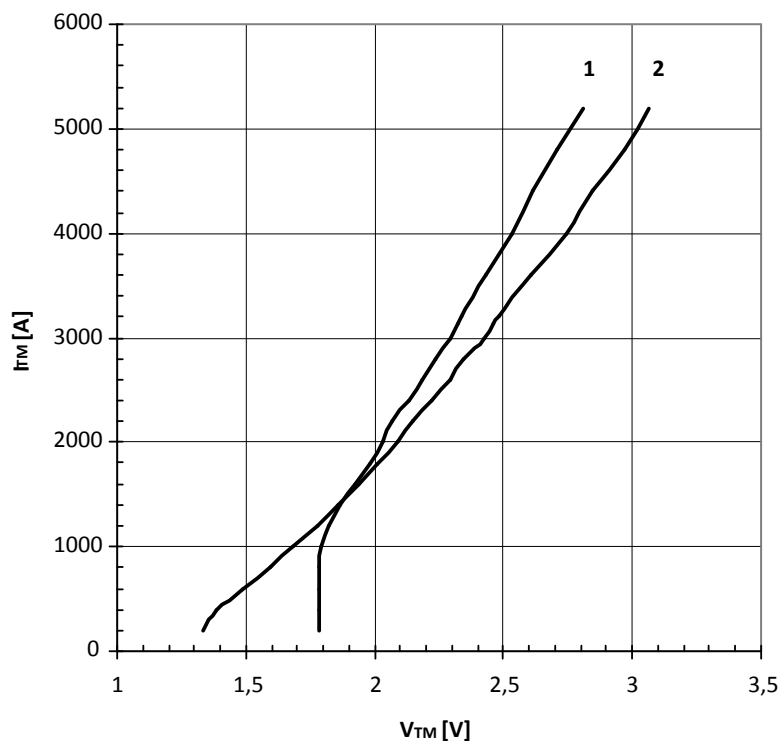
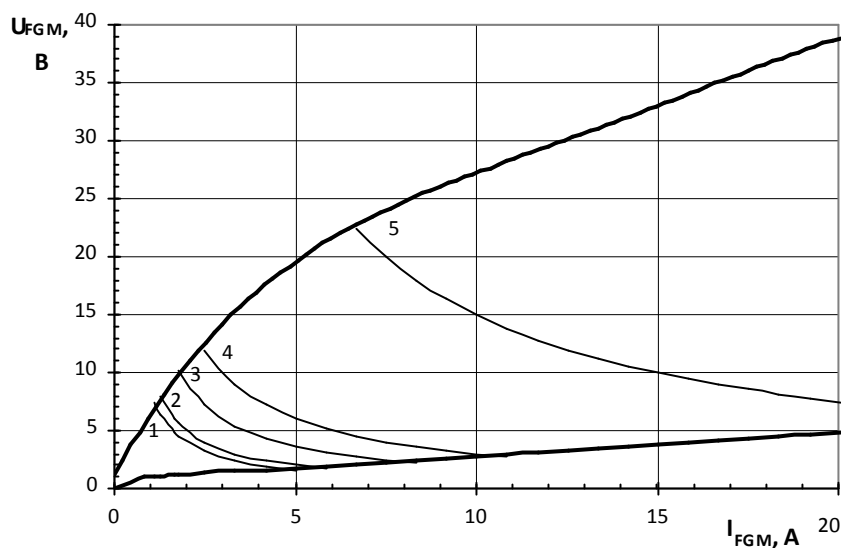


Рис.1 – Предельная вольт-амперная характеристика.
 1 – $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$
 2 – $T_j=125\text{ }^\circ\text{C}$



Максимальные потери мощности цепи управления

| Позиция | Коэф. времени вкл.-выкл. | Длина импульса управл., мс | Энергия импульса цепи управл., Вт |
|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | DC | 8 |
| 2 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | 20 | 1 | 18 |
| 4 | 40 | 0.5 | 30 |
| 5 | 200 | 0.1 | 150 |

Рис.2 — Вольт-амперная характеристика цепи управления

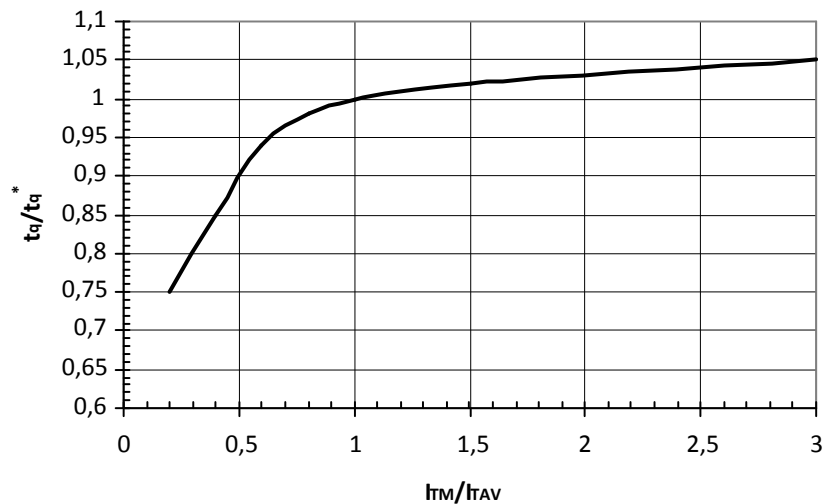


Рис. 3 — Зависимость времени выключения t_q от амплитуды тока в открытом состоянии I_{TM}

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $di_R/dt=10$ А/мкс; $U_R=100$ В; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

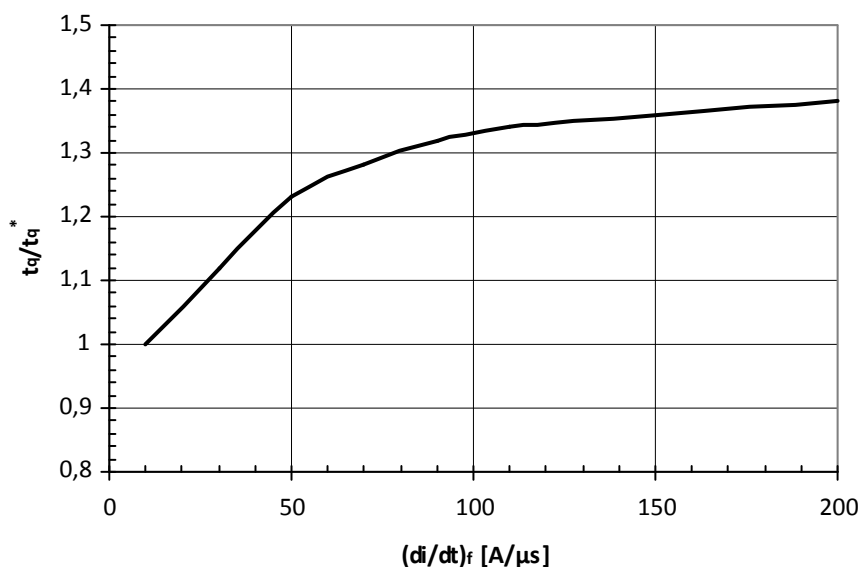


Рис. 4 — Зависимость времени выключения t_q от скорости спада анодного тока di_R/dt

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $U_R=100$ В; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

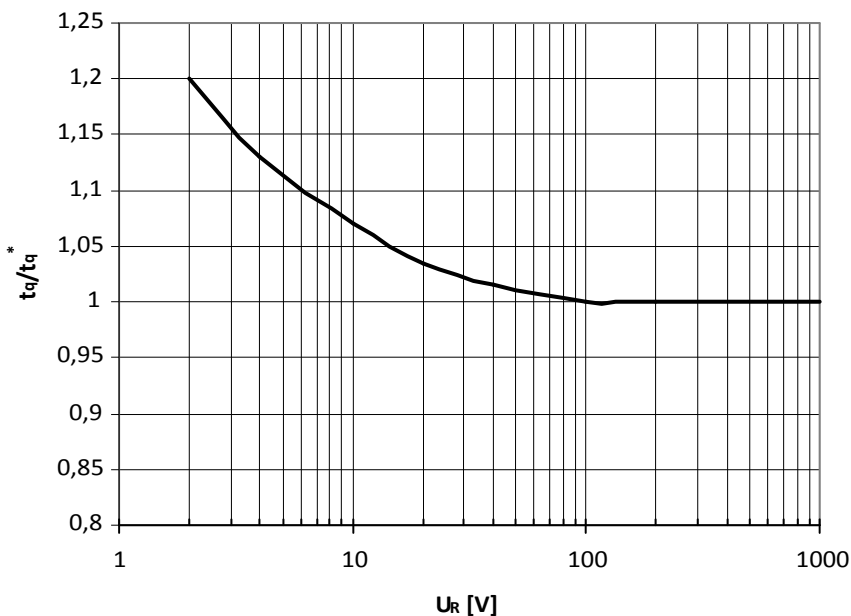


Рис. 5 — Зависимость времени выключения t_q от обратного напряжения U_R

Условия: $T_j=T_{j\max}$; $I_{TM}=I_{TAV}$; $di_R/dt=10$ А/мкс; $du_D/dt=50$ В/мкс; $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* – см. информационный лист, $du_D/dt=50$ В/мкс)

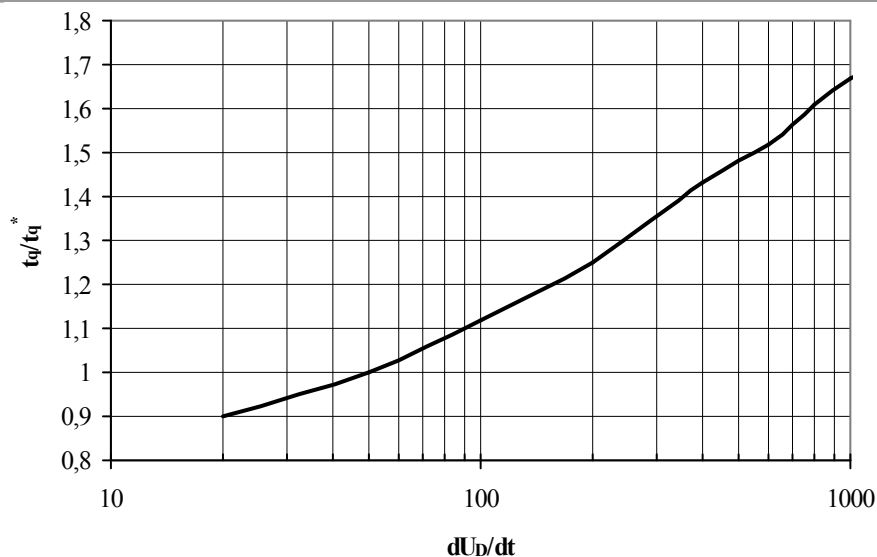


Рис. 6 — Зависимость времени выключения t_q от скорости нарастания напряжения du_D/dt

Условия: $T_j = T_{j \max}$; $I_{TM} = I_{TAV}$; $di_R/dt = 10$ А/мкс; $U_R = 100$ В; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$

Типичное изменение t_q относительно нормированного t_q^* (t_q^* — см. информационный лист, $du_D/dt = 50$ В/мкс)

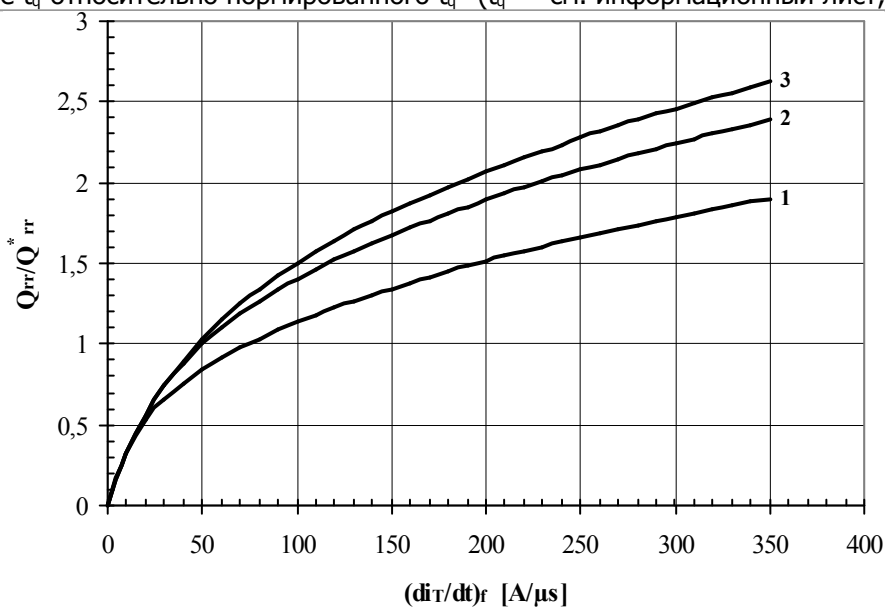


Рис. 7 — Зависимость заряда обратного восстановления Q_{rr} от скорости спада анодного тока di_R/dt

1 — $I_{TM} = 0.5 \cdot I_{TAV}$,

2 — $I_{TM} = I_{TAV}$,

3 — $I_{TM} = 1.5 \cdot I_{TAV}$

Условия: $T_j = T_{j \max}$; $U_R = 100$ В

Типичное изменение Q_{rr} относительно нормированного Q_{rr}^* (Q_{rr}^* — см. информационный лист)

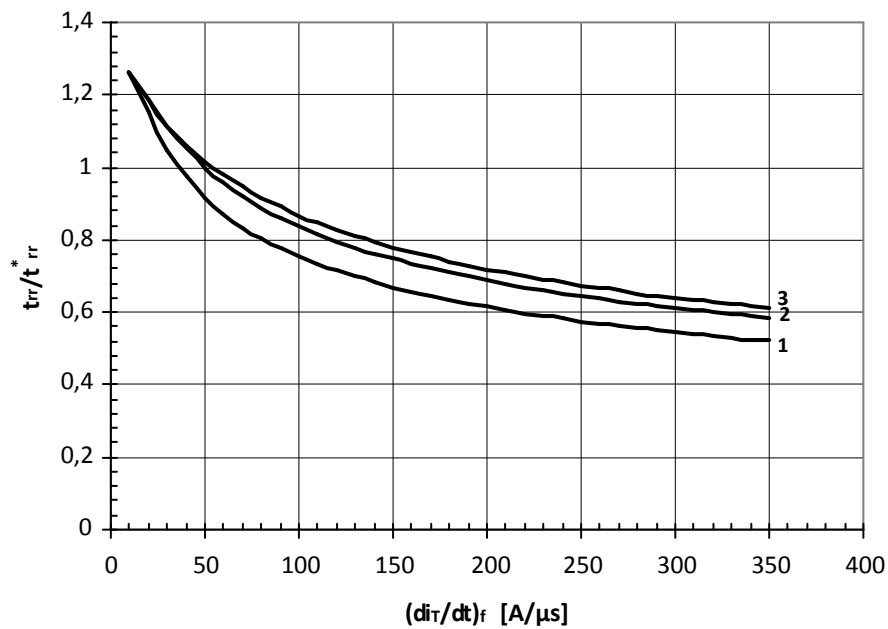


Рис. 8 — Зависимость времени обратного восстановления t_{rr} от скорости спада анодного тока di_R/dt

- 1 — $I_{TM} = 0.5 I_{TAV}$,
- 2 — $I_{TM} = I_{TAV}$,
- 3 — $I_{TM} = 1.5 I_{TAV}$

Условия: $T_j = T_{j\max}$; $U_R = 100$ В

Типичное изменение t_{rr} относительно нормированного t_{rr}^* (t_{rr}^* — см. информационный лист)

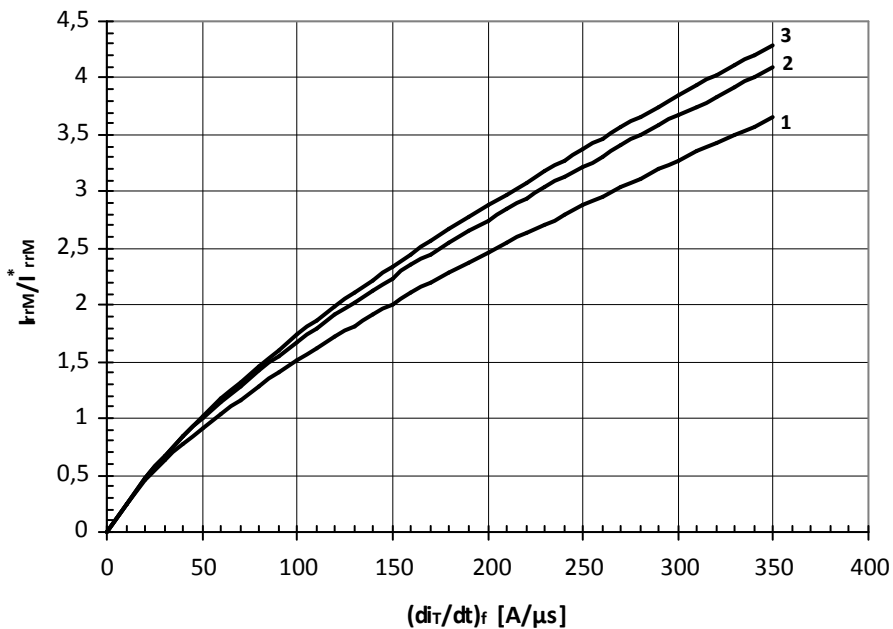


Рис. 9 — Максимальная зависимость тока обратного восстановления I_{rrM} от скорости спада анодного тока di_R/dt

- 1 — $I_{TM} = 0.5 I_{TAV}$,
- 2 — $I_{TM} = I_{TAV}$,
- 3 — $I_{TM} = 1.5 I_{TAV}$

Условия: $T_j = T_{j\max}$; $U_R = 100$ В

Типичное изменение I_{rrM} относительно нормированного I_{rrM}^* (I_{rrM}^* — см. информационный лист)

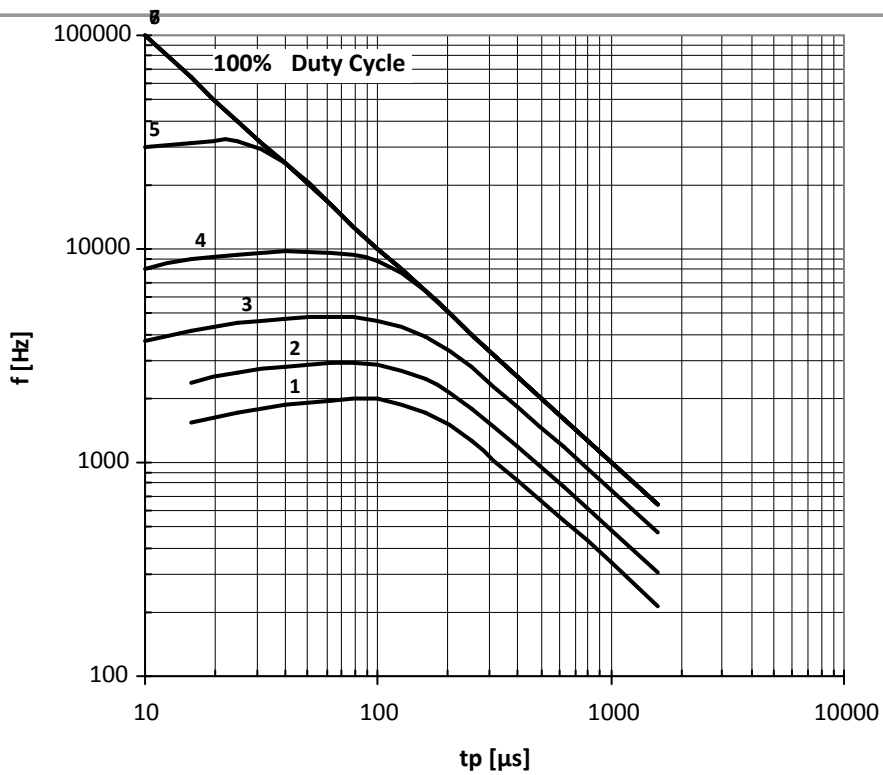


Рис. 10 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_C = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

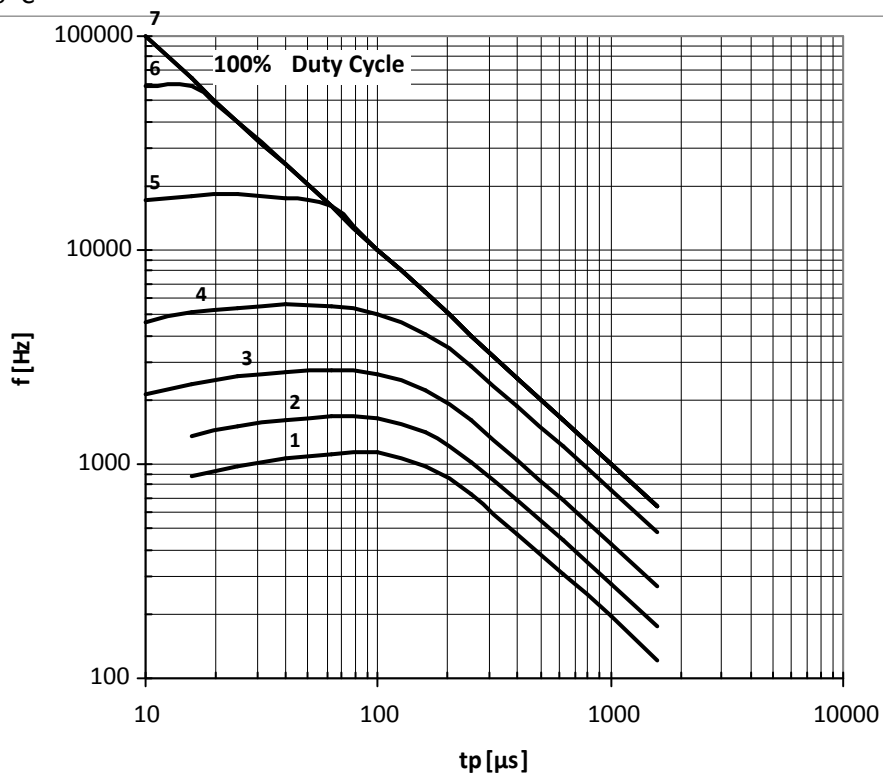


Рис. 11 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 – $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_C = 75 \text{ }^\circ\text{C}$

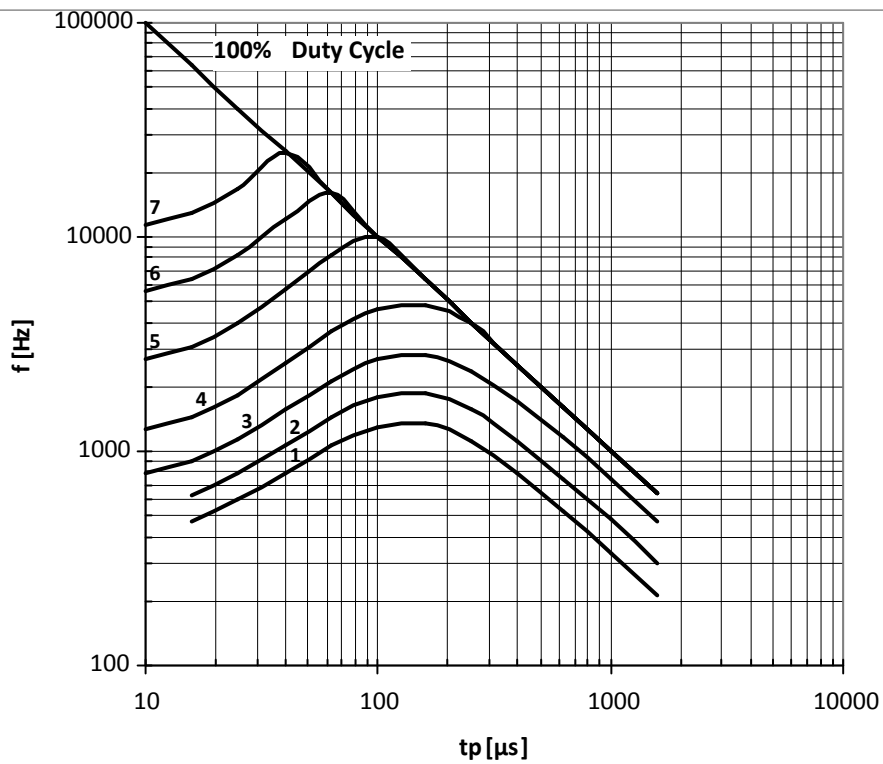


Рис. 12 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 — $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 — $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 — $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 — $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 — $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 — $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 — $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

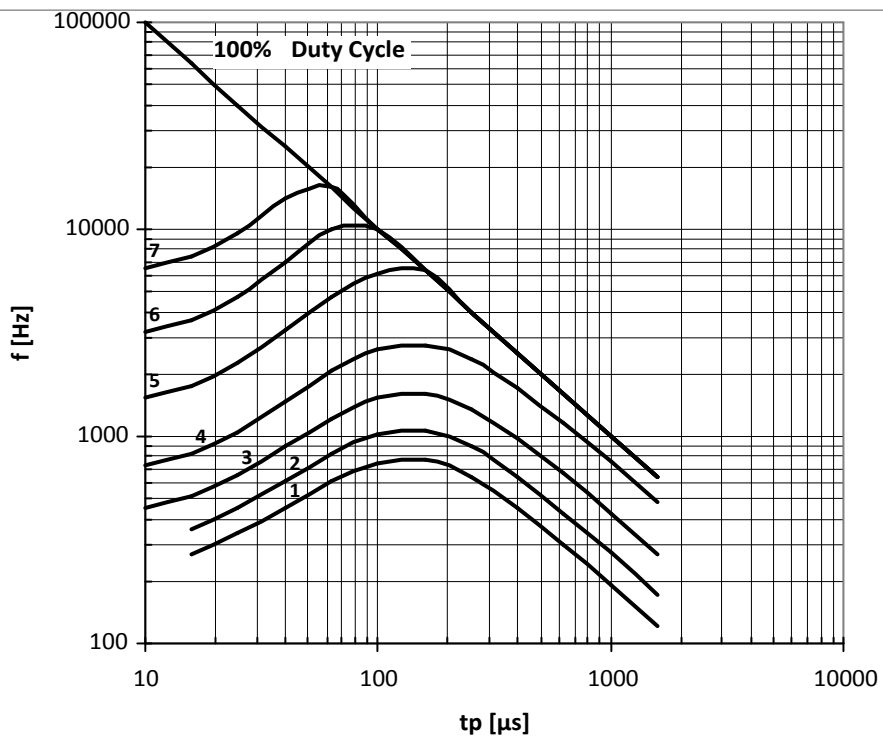


Рис. 13 — Зависимость частоты синусоидальных импульсов тока от длительности импульсов тока

- 1 — $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 — $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 — $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 — $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 — $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 — $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 — $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_C = 75 \text{ }^\circ\text{C}$

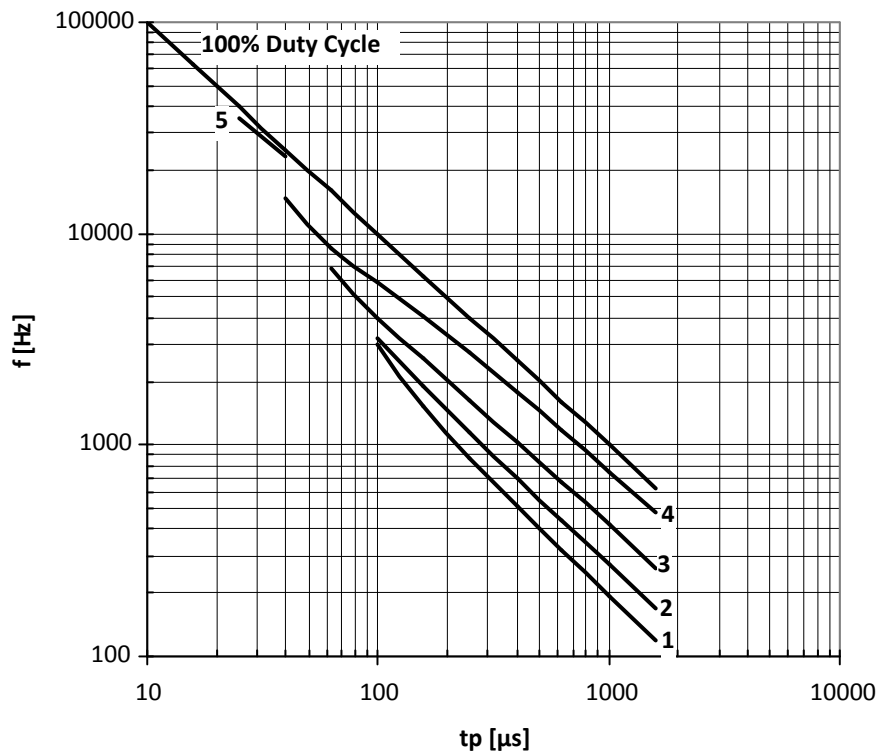


Рис. 14 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_c = 55$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 100$ А/мкс

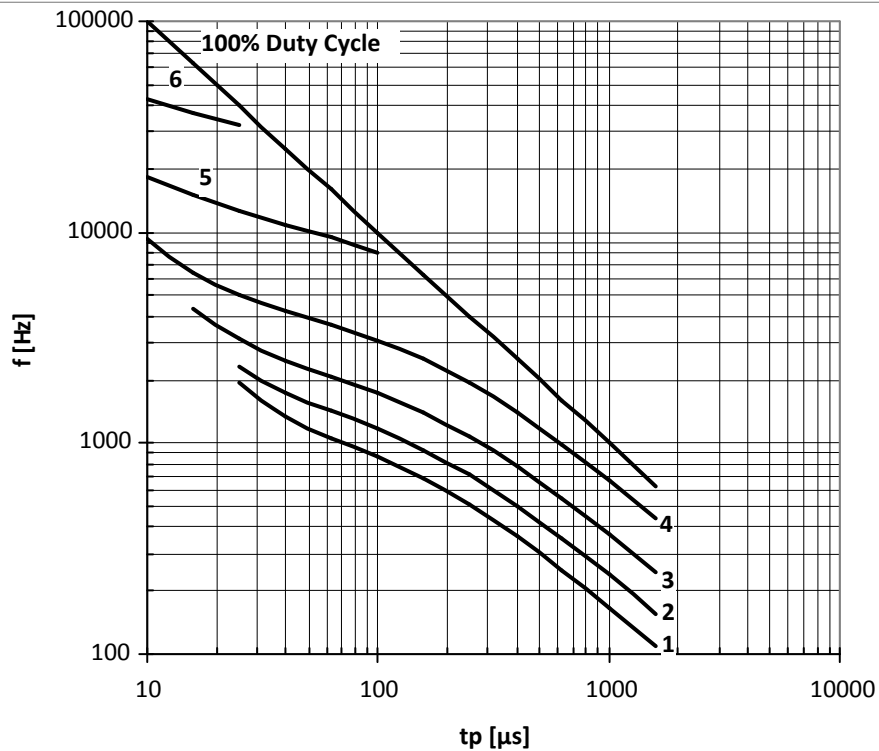


Рис. 15 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $T_c = 55$ °С; $di_f/dt = di_R/dt = 500$ А/мкс

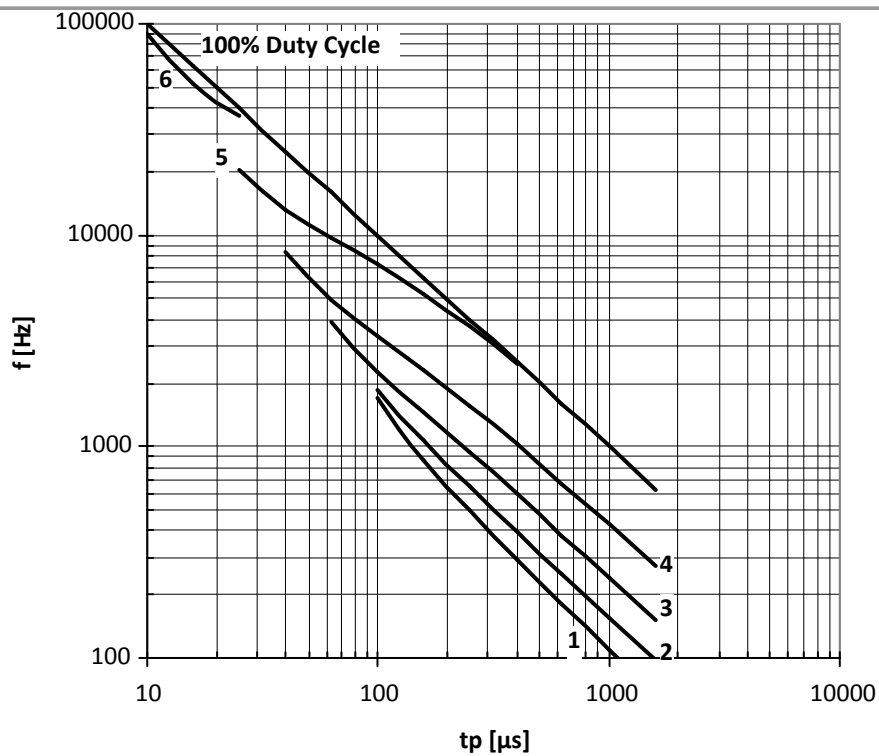


Рис. 16 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_C = 75 \text{ }^\circ\text{C}$; $di_F/dt = di_R/dt = 100 \text{ А/мкс}$

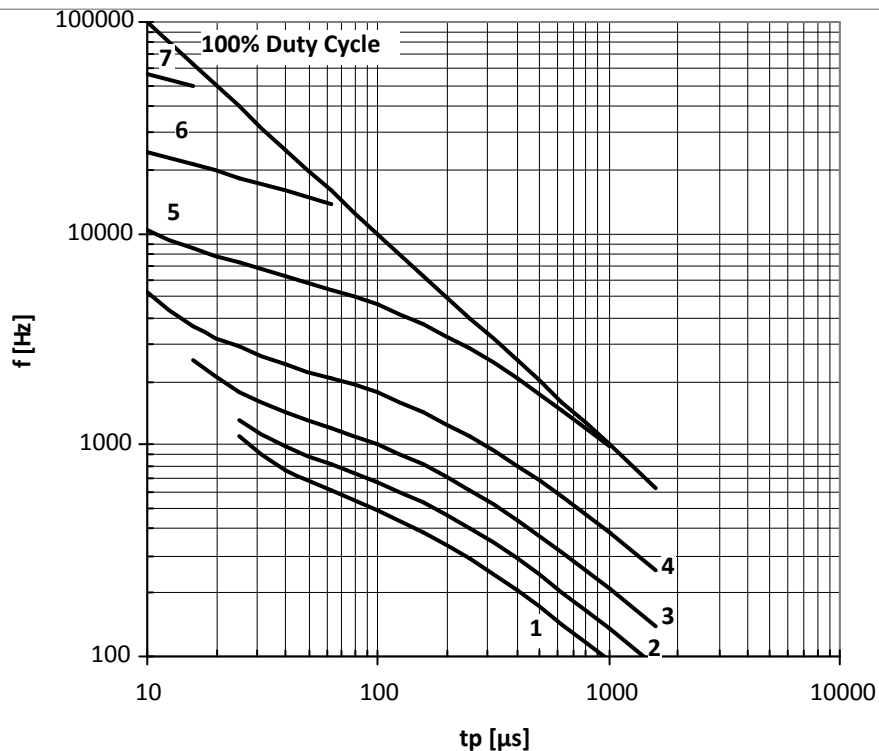


Рис. 17 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 – $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R \leq 3 \text{ В}$; $T_C = 85 \text{ }^\circ\text{C}$; $di_F/dt = di_R/dt = 500 \text{ А/мкс}$

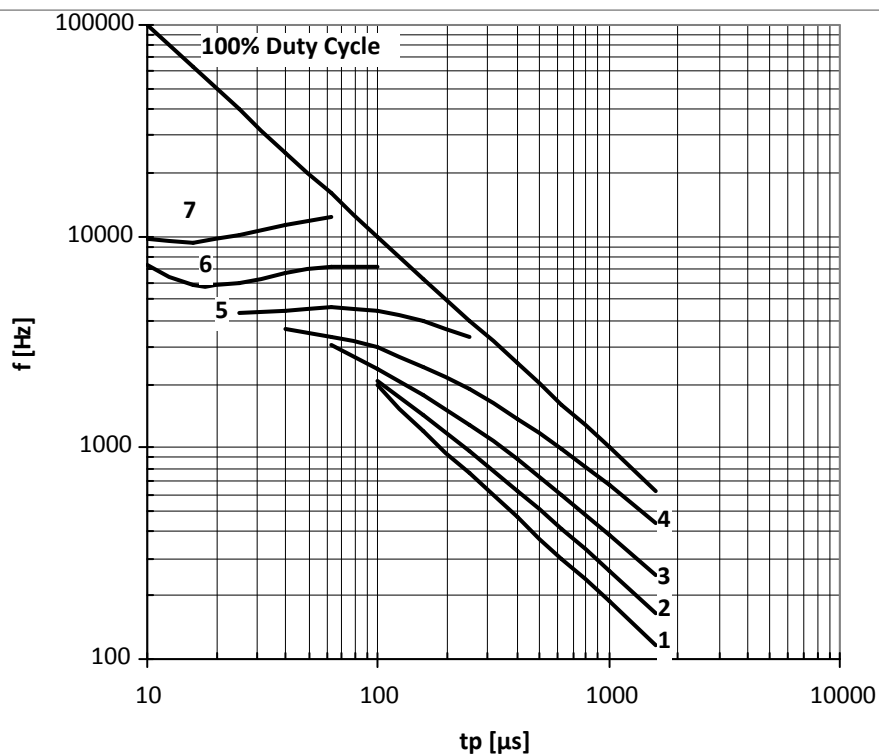


Рис. 18 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 – $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_c = 55 \text{ }^\circ\text{C}$; $di_f/dt = di_r/dt = 100 \text{ A/мкс}$

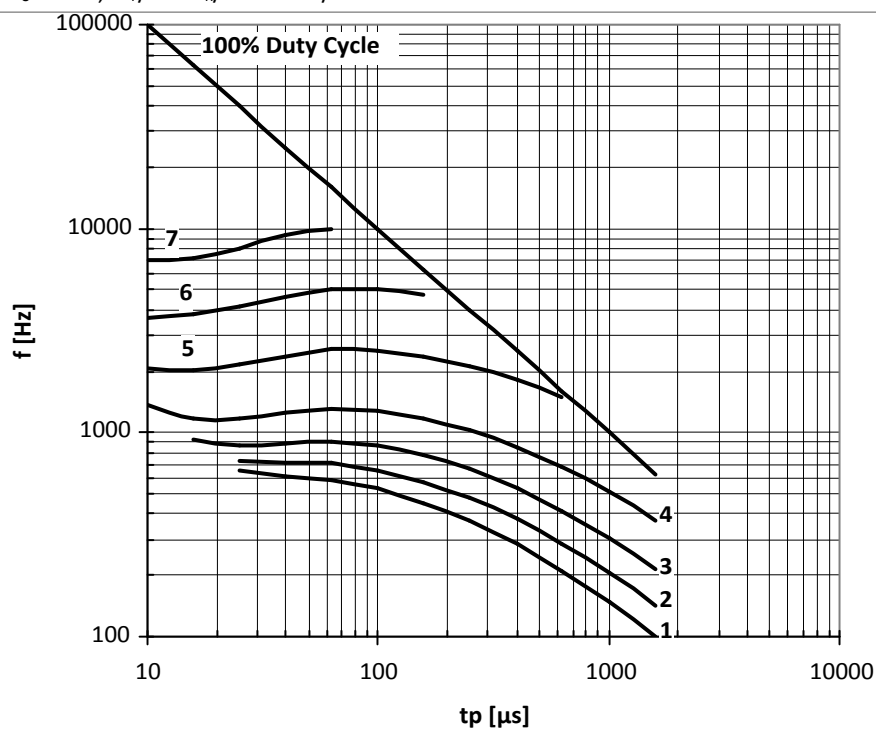


Рис. 19 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000 \text{ A}$
- 2 – $I_{TM} = 4000 \text{ A}$
- 3 – $I_{TM} = 3000 \text{ A}$
- 4 – $I_{TM} = 2000 \text{ A}$
- 5 – $I_{TM} = 1000 \text{ A}$
- 6 – $I_{TM} = 500 \text{ A}$
- 7 – $I_{TM} = 250 \text{ A}$

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $T_c = 55 \text{ }^\circ\text{C}$; $di_f/dt = di_r/dt = 500 \text{ A/мкс}$

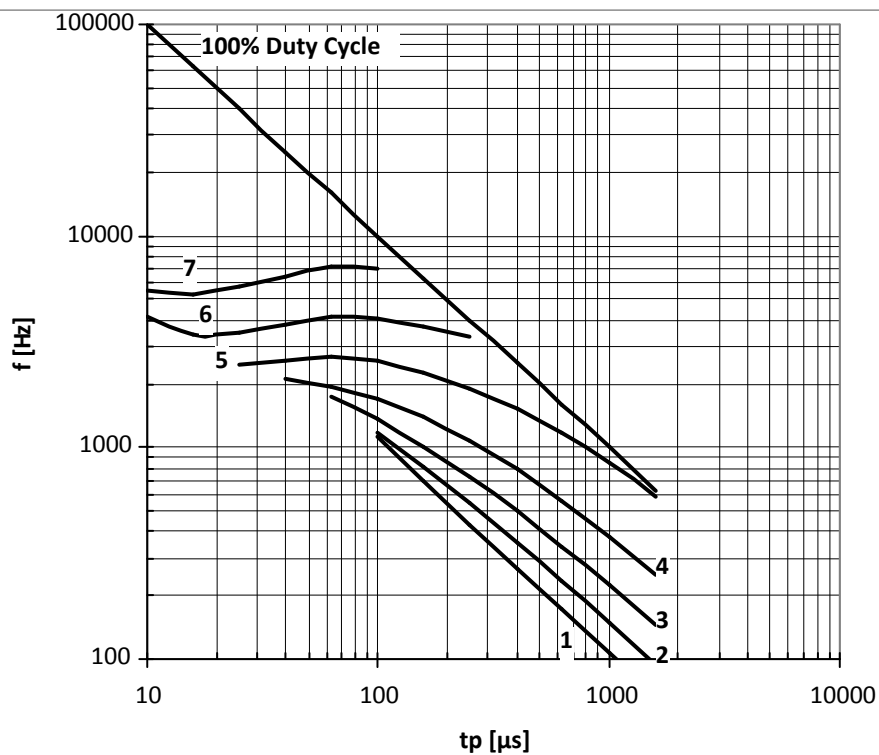


Рис. 20 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 U_{RRM}$; $T_c = 75$ °C; $di_f/dt = di_R/dt = 100$ A/мкс

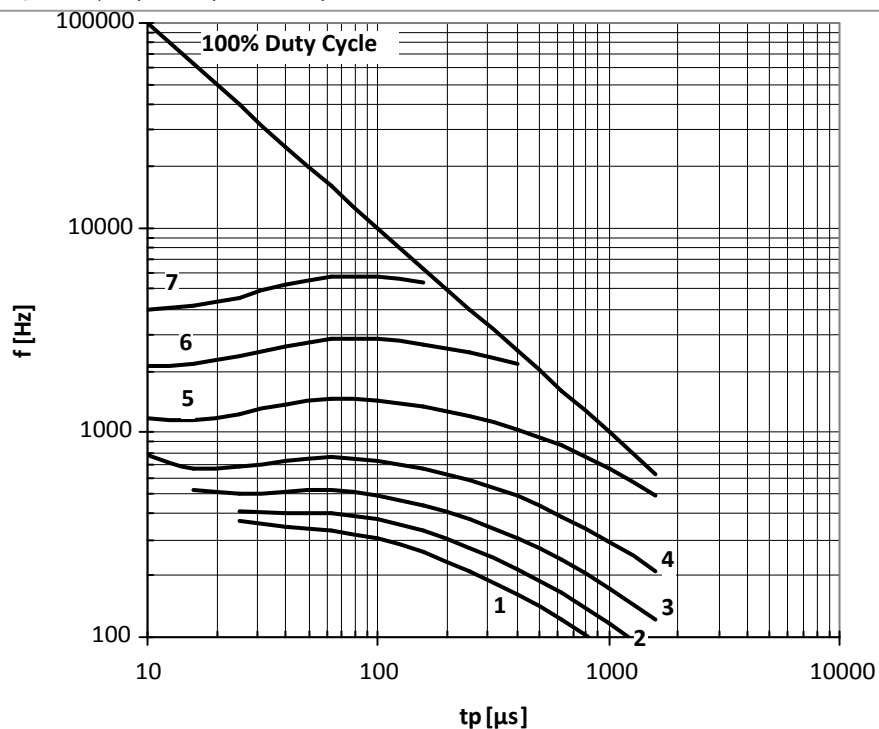


Рис. 21 — Зависимость частоты прямоугольных импульсов тока от длительности импульсов

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 U_{RRM}$; $T_c = 75$ °C; $di_f/dt = di_R/dt = 500$ A/мкс

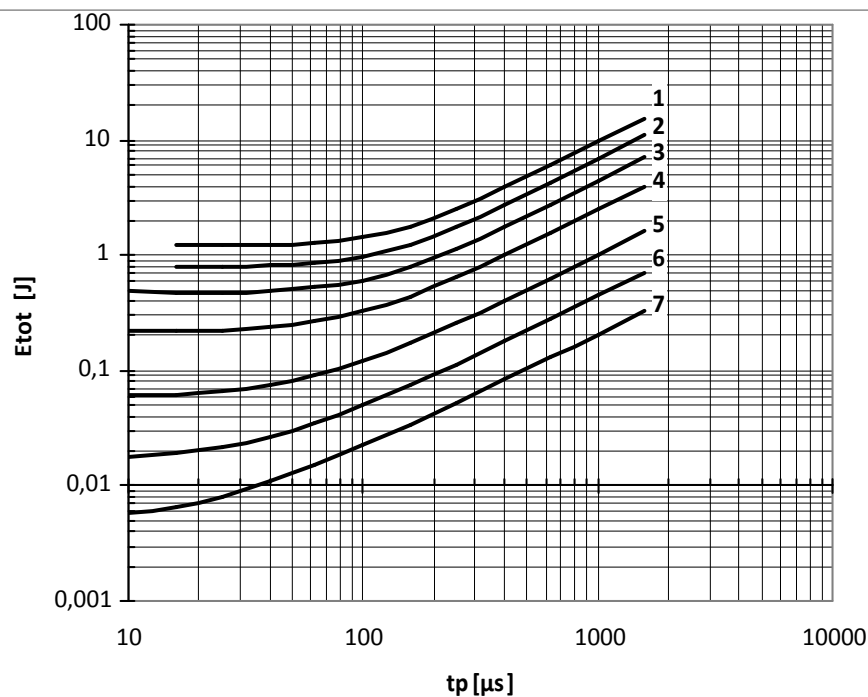


Рис. 22 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \neq 3$ В

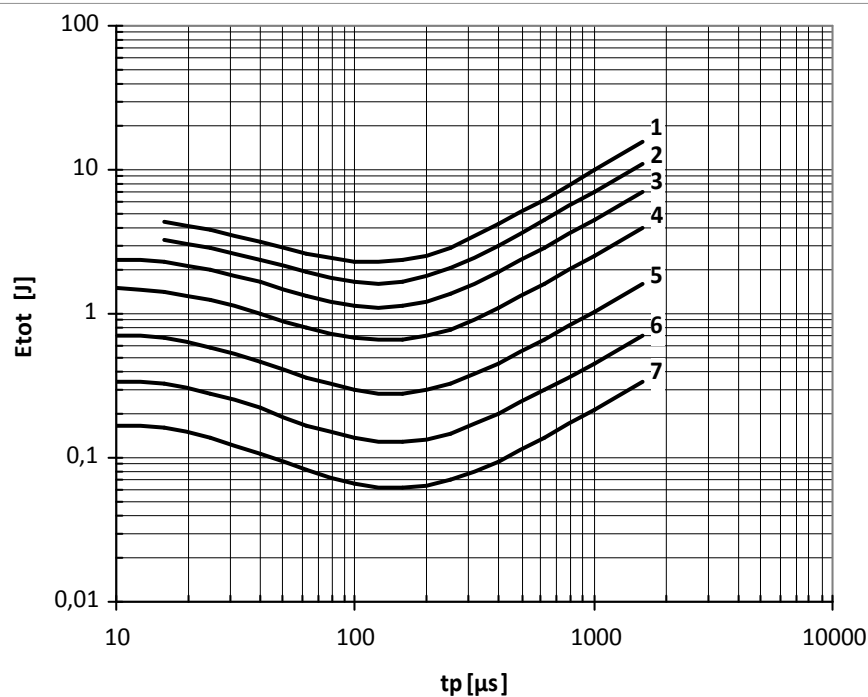


Рис. 23 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$

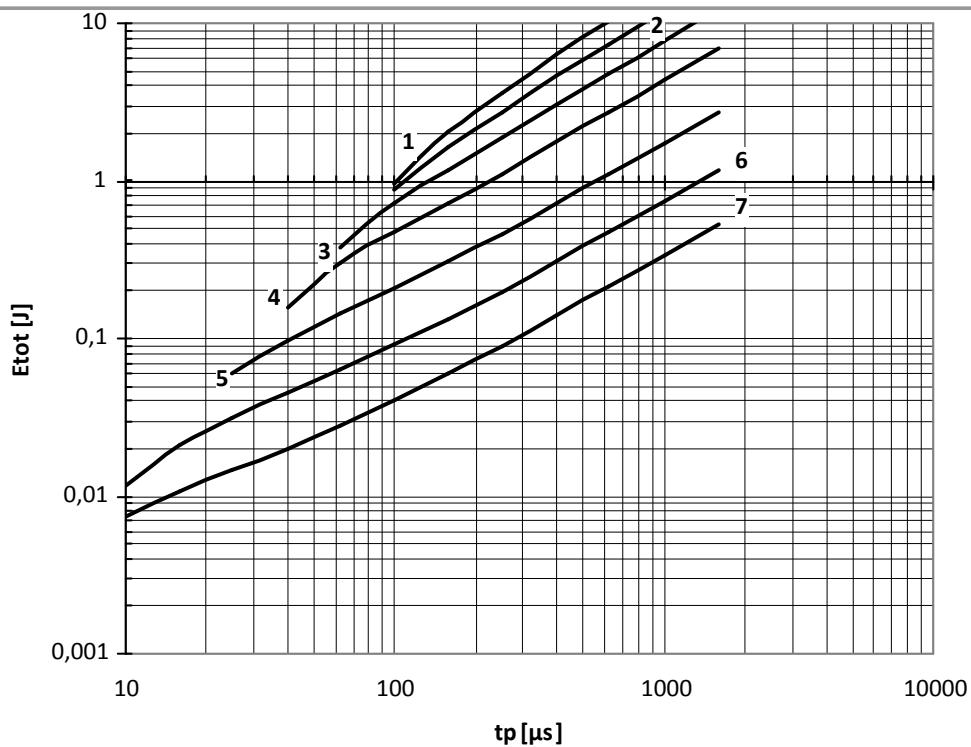


Рис. 24 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ А/мкс

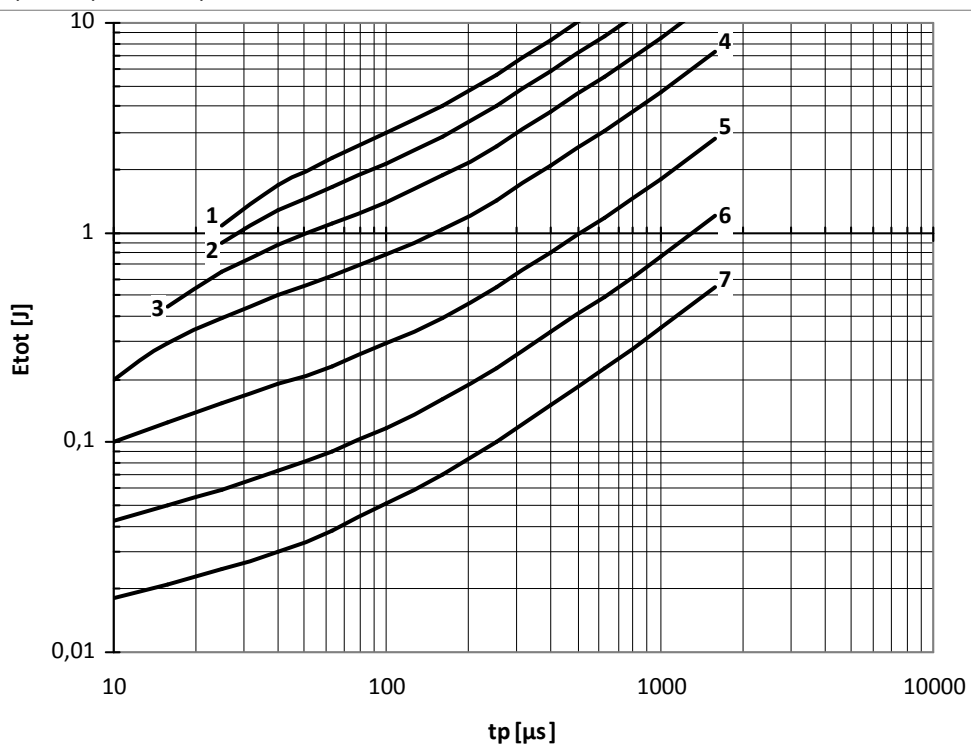


Рис. 25 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R \leq 3$ В; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ А/мкс

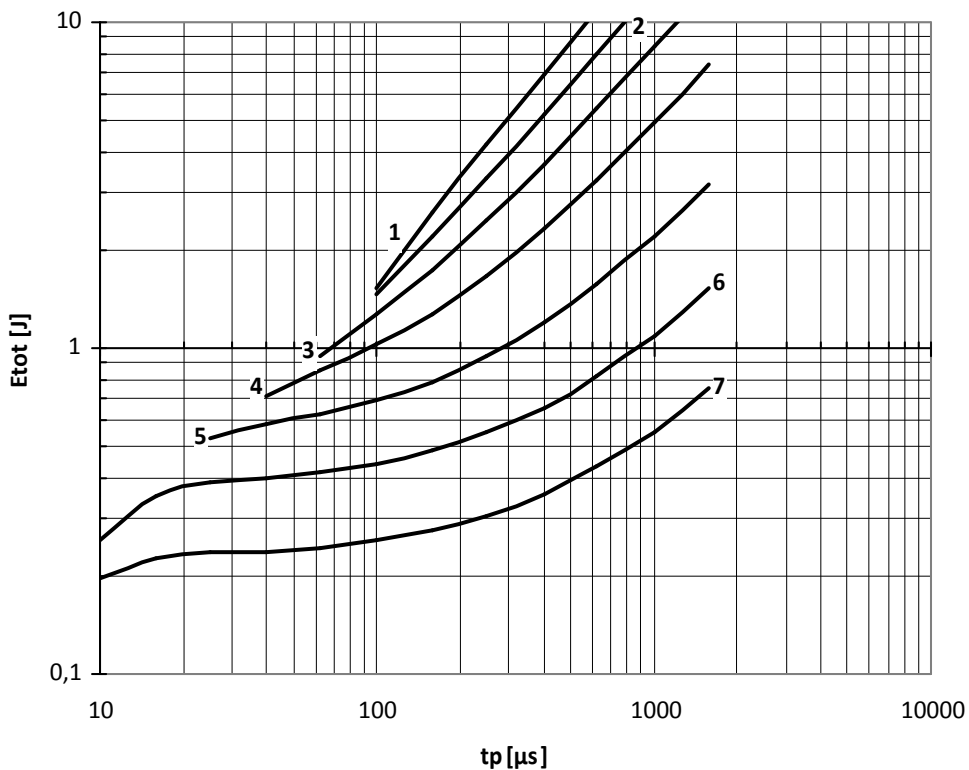


Рис. 26 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 100$ A/мкс

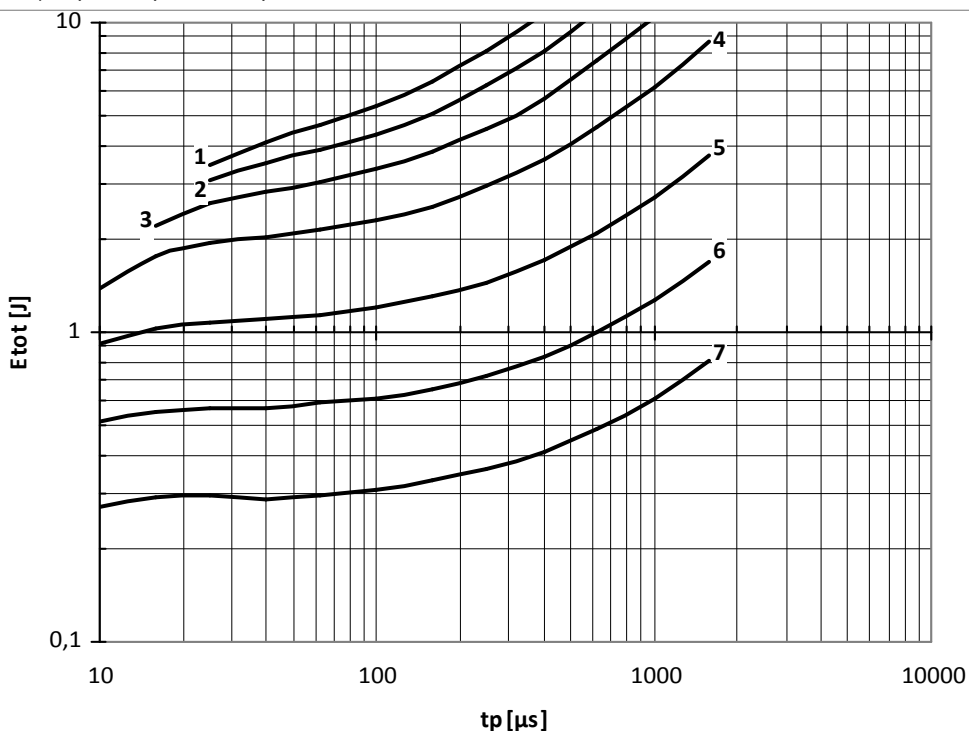


Рис. 27 – Зависимость энергии потерь за один синусоидальный импульс тока от длительности импульса

- 1 – $I_{TM} = 5000$ A
- 2 – $I_{TM} = 4000$ A
- 3 – $I_{TM} = 3000$ A
- 4 – $I_{TM} = 2000$ A
- 5 – $I_{TM} = 1000$ A
- 6 – $I_{TM} = 500$ A
- 7 – $I_{TM} = 250$ A

Условия: $U_R = 0.67 \cdot U_{RRM}$; $di_F/dt = di_R/dt = 500$ A/мкс

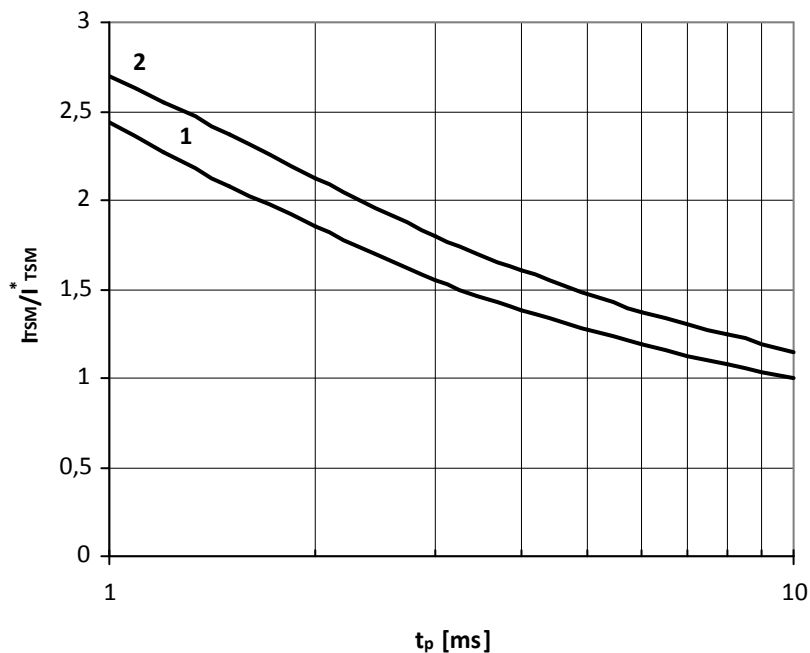


Рис. 28 – Зависимость ударного тока I_{TSM} от длительности импульса t_p для полусинусоидального импульса
 1 – $T_j=125\text{ °C}$
 2 – $T_j=25\text{ °C}$

Условия: $U_R=0\text{ В}$ – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j=T_{j\text{max}}$)

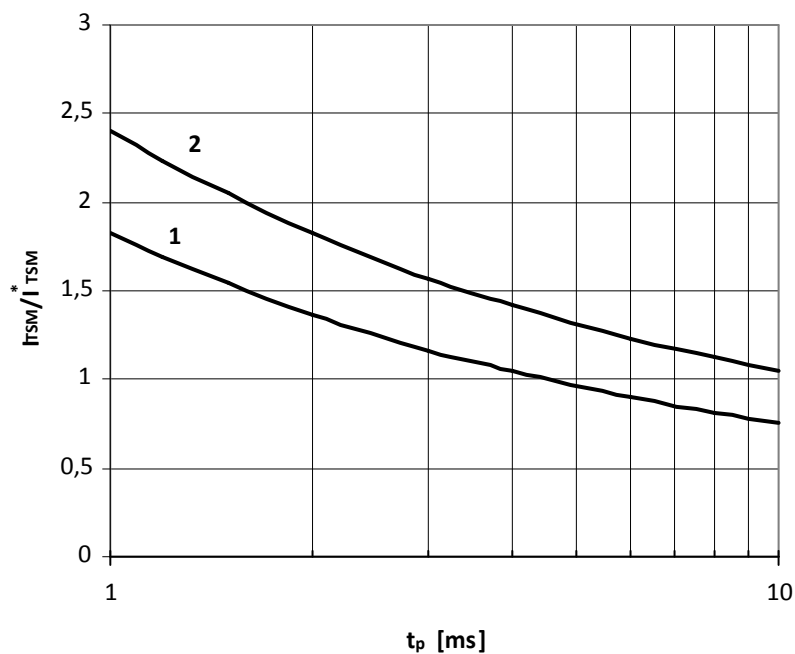


Рис. 29 – Зависимость ударного тока I_{TSM} от длительности импульса t_p для полусинусоидального импульса
 1 – $T_j=125\text{ °C}$
 2 – $T_j=25\text{ °C}$

Условия: $U_R=0.8 \cdot U_{RRM}$ – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j=T_{j\text{max}}$)

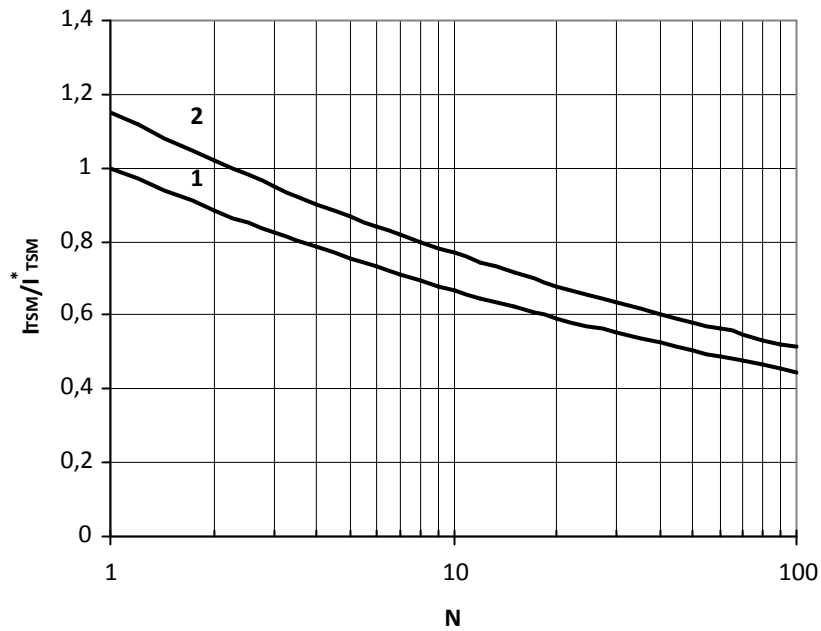


Рис. 30 – Ударный ток I_{TSM} от количества полусинусоидальных импульсов тока длительностью 10 мс
 1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$
 2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R = 0$ В – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j = T_{j\text{max}}$)

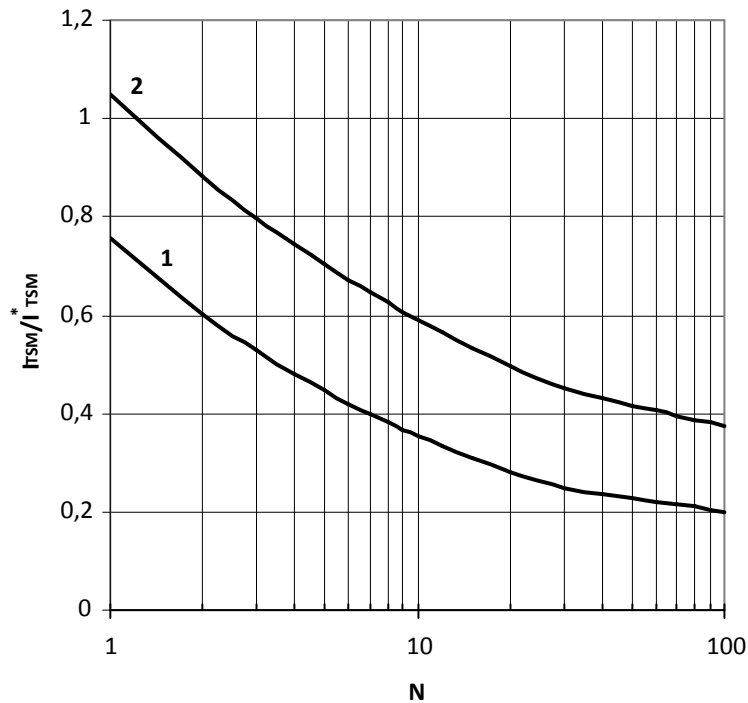


Рис. 31 – Ударный ток I_{TSM} от количества полусинусоидальных импульсов тока длительностью 10 мс
 1 – $T_j = 125^\circ\text{C}$
 2 – $T_j = 25^\circ\text{C}$

Условия: $U_R = 0.8 \cdot U_{RRM}$ – максимальное значение обратного напряжения, которое прикладывается сразу после ударного тока
 Типичное изменение I_{TSM} относительно нормированного I_{TSM}^* (I_{TSM}^* – см. информационный лист, $T_j = T_{j\text{max}}$)